1 Charakterystyka przejściowa tranzysotra mosfet

$$I_D = f(U_{GS}) \tag{1}$$

$$V_{DS} = const. (2)$$

| Dren (D) | SMU2 | V | CONST |
|------------|------|-----|-------|
| Źródło (S) | SMU3 | COM | CONST |
| Bramka (G) | SMU4 | V | VAR1 |

Tabela 1: Ustawienia kanałów w analizatorze półprzewodników HP4145B.

Parametry: V_DS - stale I_DS_MAX V_GS_START V_GS_STOP V_GS_STEP

Komendy GPIB:

. . .

2 Charakterystyka wyjściowa tranzysotra mosfet

$$I_D = f(V_{DS}) \tag{3}$$

$$V_{GS} = const. (4)$$

| Dren (D) | SMU2 | V | VAR1 |
|------------|------|-----|-------|
| Źródło (S) | SMU3 | COM | CONST |
| Bramka (G) | SMU4 | V | CONST |

Tabela 2: Ustawienia kanałów w analizatorze półprzewodników HP4145B.

Parametry:

V_GS - stałe

 ${\tt I_DS_MAX}$

V_DS_START

V_DS_STOP
V_DS_STEP

Komendy GPIB:

. . .